SSD-Solid State Disk m.2(2280) NVMe 2.0 4000GB (4TB) PCIe4.0x4 SAMSUNG MZ-V9S4T0BW SSD990 Evo Plus 990 R:7250MB/s -W:6300MB/s

SAMSUNG · Storage Interno · Nuovo











PREZZO

846,90 € IVA inclusa

DESCRIZIONE

Samsung MZ-V9S4T0. Capacità SSD: 4 TB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 7250 MB/s, Velocità di scrittura: 6300 MB/s, Componente per: PC

• 4 TB M.2 PCI Express 4.0

• Velocità di lettura: 7250 MB/s 1050000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)

• Velocità di scrittura: 6300 MB/s 1400000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)

• V-NAND TLC NVMe 2.0

• criptaggio hardware 256-bit AES

• Supporto S.M.A.R.T. Supporto TRIM

• Componente per: PC

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristica	**Dettaglio**
SKU	MPI-C925CCB0C2
EAN	8806095575667
Condizione	Nuovo
NVMe	Sì
Peso	9 g
Altezza	80,2 mm
Larghezza	80,2 mm
interface	NVMe SSD
Interfaccia	PCI Express 4.0
Profondità	2,38 mm
capacity_gb	4000
Tipo memoria	V-NAND TLC
Capacità SSD	4 TB
Supporto TRIM	Sì

Caratteristica	Dettaglio
Componente per	PC
Dimensione SSD	M.2
Versione di NVMe	2.0
Supporto S.M.A.R.T.	Sì
criptaggio hardware	Sì
Velocità di lettura	7250 MB/s
Lettura casuale (4KB)	1050000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
Tensione di esercizio	3,3 V
Shock di funzionamento	1500 G
Velocità di scrittura	6300 MB/s
Scrittura casuale (4KB)	1400000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
Consumo energetico (inattivo)	0,06 W
Tempo medio tra guasti (MTBF)	1500000 h
Dimensioni dell'unità SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)
Consumo di energia (in lettura)	5,5 W
Algoritmi di sicurezza supportati	256-bit AES
Consumo di energia (in scrittura)	4,8 W
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C

Caratteristica	Dettaglio
Supporto di DevSlp (standby del dispositivo)	Sì
Consumo di corrente DevSlp (modalità di attesa)	5 mW

Scheda tecnica generata il 7 novembre 2026. Prezzi e disponibilità possono subire variazioni; fanno fede le condizioni pubblicate su mpinformaticasrl.it al momento dell'ordine.